

{joomplu:1735}С 7 по 8 июня 2021 года в г. Лыткарино в ДК «МИР» прошла 25-я Всероссийская научно-техническая конференция «Радиационная стойкость электронных систем» (СТОЙКОСТЬ-2022). В конференции приняло участие 226 участников из 30 организаций, было представлено всего 108 стендовых и 27 устных докладов, из которых сотрудники Консорциума «ЭНПО СПЭЛС» - НИЯУ МИФИ» представили 40 стендовых и 8 устных докладов, в том числе на актуальные темы в развитие принятого в марте 2021 года КГВС «Климат-8»:

Армен Вагоевич Согоян

А.В. Согоян

1,2

1

НИЯУ МИФИ

Методы

Александр Иннокентьевич Чумаков

А.И. Чумаков

1,2

1

НИЯУ МИФИ,

Оценка уровней сбоев в ИС при нейтронном воздействии различной интенсивности

Андрей Борисович Каракозов

**А.Б. Каракозов**, В.А. Марфин, К.А. Москаленко

НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Исследование вероятности сбоя цифровых сложно-функциональных микросхем при импульсно-

Николай Александрович Усачев

**Н.А. Усачев**, Д.И. Сотсков, Н.М. Жидков, И.

НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Цифровые модели ЭКБ для радиоэлектронной аппаратуры доверенного назначения

Никита Михайлович Жидков

**Н.М. Жидков**, Д.И. Сотсков, К.М. Амбуркин,

НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Показатели стойкости	GaAs
----------------------	------

Александр Александрович Печенкин

А.Н. Егоров, О.Б. Маврицкий,	<u>А.А. Печенкин</u>
------------------------------	----------------------

НИЯУ МИФИ,	АО «ЭНПО СПЭЛС»
------------	-----------------

Практический опыт использования двухфотонного поглощения лазерного излучения для исследования

Андрей Георгиевич Петров

<u>А.Г. Петров</u>	, И.И. Швецов-Шиловский, С.Б.
--------------------	-------------------------------

НИЯУ МИФИ,	АО «ЭНПО СПЭЛС»
------------	-----------------

Сравнительный анализ стойкости резистивной и других видов ИСРГ не зависящей памяти к воздействию

Андрей Александрович Аникин

<u>А.А. Аникин</u>	, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов
--------------------	-------------------------------------

НИЯУ МИФИ,

АО «ЭНПО СПЭЛС»

Особенности проведение испытаний на импульсную электрическую прочность в активном элек